



IX Международная конференция и VIII Школа молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, наноразмерных структур и приборов на его основе

КРЕМНИЙ-2012

9-13 июля 2012
Санкт-Петербург
www.si2012.org

"Кремний 2012" является продолжением серии конференций, состоявшихся в Москве (2007, 2011), Черноголовке (2008), Новосибирске (2009) и Нижнем Новгороде (2010). Этот форум собирает ученых, представляющих академическое сообщество, ВУЗы и промышленность России, стран СНГ и дальнего зарубежья, и позволяет обсудить актуальные проблемы по всему кругу вопросов, включающему рост и материаловедение кристаллов и пленок кремния и родственных материалов, а также физику, технологию и диагностику наноструктур на их основе. Одновременно с конференцией будет проведена школа молодых ученых и специалистов, на которой признанными экспертами будут прочитаны лекции по актуальным вопросам современной электроники. На конференции будут представлены приглашенные доклады ведущих ученых, работающих в области материаловедения кремния и его применений, а также устные и стендовые доклады, отобранные Оргкомитетом из числа присланных тезисов.

Организаторы конференции

Учреждение Российской академии наук
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

Научный Совет РАН «Физико-химические основы полупроводникового материаловедения»

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Организационный комитет

Н.А. Соболев	ФТИ РАН (С.Петербург)	председатель
М.Я. Дашевский	НИТУ МИСиС (Москва)	зам. председателя
М.В.Заморянская	ФТИ РАН (С.Петербург)	зам. председателя
Е.В. Иванова	ФТИ РАН (С.Петербург)	секретарь

Асеев А.Л.	Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск
Бердников В.С.	Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск
Вывенко О.Ф.	СПбГУ, Санкт-Петербург
Вяткин А.Ф.	ИПТМ РАН, Черноголовка
Герасименко Н.Н.	МИЭТ, Москва
Грехов И.В.	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Грибов Б.Г.	ОАО «НИИ Особо чистых материалов», Москва
Двуреченский А.В.	Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск
Ежлов В.С.	МИСиС, Москва
Елютин А.В.	ОАО «Гиредмет», Москва
Земсков В.С.	Институт металлургии им. А.А. Байкова, Москва
Казанский А.Г.	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
Кведер В.В.	ИФТТ РАН, Черноголовка
Кобелева С.П.	МИСиС, Москва
Новиков А.В.	Институт физики микроструктур РАН, Н.Новгород
Красников Г.Я.	ОАО «НИИ Молекулярной электроники и завод «Микрон», Москва
Критская Т.В.	Запорожская государственная академия, Запорожье
Кришан Лал (Krishan Lal)	Индийская национальная академия наук
Кузнецов Ф.А.	Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск
Литовченко В.Г.	Институт физики полупроводников им. Лашкарева НАНУ, Киев
Макеев Х.И.	ОАО «ГИРЕДМЕТ», Москва
Наумов А.В.	ОАО «НПП КВАНТ» Москва
Непомнящих А.И.	ИГХ СО РАН, Иркутск
Орликовский А.А.	Физико-технологический институт РАН, Москва
Пархоменко Ю.Н.	ОАО «ГИРЕДМЕТ», Москва
Пчеляков О.П.	Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск
Сорокин Л.М.	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Таиров Ю.М.	СПбГЭТУ (ЛЭТИ), Санкт-Петербург
Федотов А.К.	Белорусский государственный университет, Минск
Харченко В.А.	ОАО «НТЦ РЭБ», Москва
Харченко Л.Ю.	Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск
Шульпина И.Л.	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Якимов Е.Б.	ИПТМ РАН, Черноголовка

Программа конференции посвящена следующим вопросам

1. Кристаллы и пленки Si, SiGe и Ge: технологии получения и свойства поликристаллических, мульткристаллических, монокристаллических, аморфных и пористых материалов

2. Дефекты и примеси в кристаллах и пленках Si, SiGe и Ge. Модификация свойств материалов под влиянием термических обработок, радиационного облучения и других воздействий
3. Приборные структуры на основе кремния для микро-, опто-, солнечной и силовой электроники, микромеханики и других применений
4. Наноразмерные структуры на основе кремния: технологии получения и свойства квантово-размерных структур, скрытых и напряженных слоев; их использование для твердотельной электроники
5. Другие твердотельные структуры на подложках кремния для нано- и оптоэлектроники, спинтроники и фотоники
6. Диагностика кремния и приборных структур на его основе

Важные даты

24 января	Регистрация на сайте конференции
24 февраля	Завершение приема тезисов
13 апреля	Извещение о включении доклада в программу
9 июля	Школа молодых ученых и специалистов
10-13 июля	Конференция

Конференция и школа будут проводиться в конференц-зале ФТИ им. А.Ф. Иоффе.

Тезисы будут приниматься только в электронном виде. Порядок оформления электронных документов и шаблонов тезисов будут выложены на сайте Конференции www.si2012.org.

Сборник тезисов будет выпущен к началу конференции и будет выдаваться участникам, оплатившим оргвзнос.

Рабочий язык конференции и школы - русский. Тезисы принимаются на русском и английском языках.

Проживание участников будет организовано в гостиницах «Спутник» и «Орбита».

КОНТАКТЫ

**194021, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д.26
secretary@si2012.org
Иванова Екатерина Владимировна**